

半导体学报

第4卷 第2期 1983年3月

目 录

- 半导体中杂质的自电离态的理论.....甘子钊 韩汝琦 (105)
- 石墨插层化合物能带计算的一种方法.....叶 令 张开明 (117)
- 紧束缚法计算 GaAs-GaP 超晶格的能带结构及电子的有关性质
.....刘文明 李 甲 (124)
- 掺氢和掺氟无定形硅的 EHMO 研究.....蒋 平 (133)
- 硅 P-N 结电场对金施主中心空穴热发射率的影响.....陈开茅 毛晋昌 (142)
- 用硅烷和乙烯辉光放电法制备的 $a\text{-Si}_x\text{C}_{1-x}:\text{H}$ 薄膜及光电性能的研究.....
.....陈光华 张仿清 杜 宁 徐希翔 黄士生 刘 智 (149)
- GaAs 三元异质外延层厚度测量的 X 射线衍射比强度法.....杨传铮 (154)
- 半导体 DH 条型注入激光器中侧向载流子波导引起的本征自脉动.....
.....郭长志 汪凯戈 (161)
- 半导体多层结构的热应变弯曲和层应力.....冯哲川 刘弘度 (171)

研究简报

- 大面积砷化镓的等离子体氧化及氧化层的 AES 和 XPS 分析
.....张冠生 唐厚舜 黄杜森 余夕同 赵国珍 钮成法 (181)
- $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ 中 N-等电子陷阱的研究.....李涵秋 陆 奋 (187)
- 金属-半导体欧姆接触的接触电阻率.....陈存礼 (191)
- 用光吸收法测量半绝缘 GaAs 中 Cr 浓度的定标曲线.....
.....许振嘉 张泽华 孙伯康 (194)
- 汽相外延 InP黄善祥 (197)
- 可见光—红外光 GaAlAs 激光器的研究...郑广富 廖先炳 郑显明 胡恩智 (200)
- 利用离子注入硅及 Nd:YAG 连续激光退火制备厘米波段雪崩管.....
.....朱美芳 姚德成 刘世祥 石万全 杨丽华 (206)